2SA606, 607／2SC959, 960

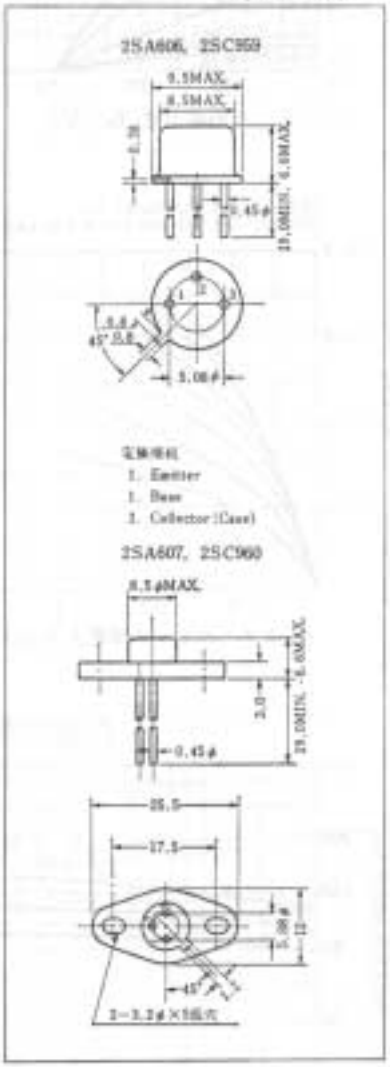
PNP／NPN エピタキシアル形シリコントランジスタ／
PNP／NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用／Audio Frequency Amplifier

特　徴／FEATURES

・実効出力30～50Wのステレオアンプのドライバとして最適。
Suitable for Driver of 30 to 50 watts Audio Amplifiers.
・電流増幅率の電流に対するリニアリティがよい。
Excellent Current gain linearity.

外形図／PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS（T_a=25℃）

項　目	略　号	2SA606	2SA607	2SC559	2SC960	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−100	−100	120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−80	−80	80	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5.0	−5.0	5.0	5.0	V
コレクタ電流（直流）	$I_{C(DC)}$	−0.7	−0.7	0.7	0.7	A
コレクタ電流（パルス）	$I_{C(pulse)}$*	−1.2	−1.2	1.2	1.2	A
全損失	P_T(T_C=25℃)	0.7	1.0	0.7	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150				℃
保存温度	T_{stg}	−65～+150				℃

* PW≦10ms, duty cycle≦50%

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS（T_a=25℃）

項　目	略　号	条　件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=80V, I_E=0			3.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=5.5V, I_C=0			3.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	V_{CE}=5.0V, I_C=10mA*	20			
	h_{FE2}	V_{CE}=5.0V, I_C=200mA*	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=500mA, I_B=50mA*			2.0	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=10V, I_C=100mA	50			MHz
コレクタ容量	C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0			50	pF

* パルス測定　PW≦350μs　duty cycle≦2%/pulsed
h_{FE} 区分/h_{FE} classification
h_{FE2}／N：40～80　M：60～110　L：90～150　K：130～200

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor